

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 11 月 4 日 (04.11.2004)

PCT

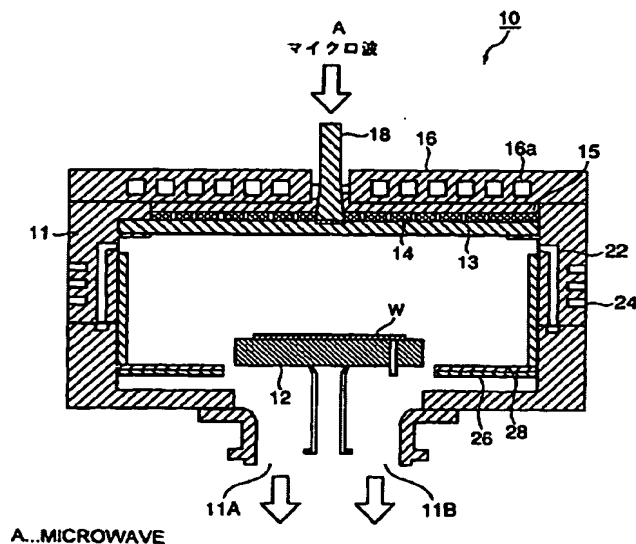
(10) 国際公開番号
WO 2004/095562 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/316, 21/336, 29/78 (72) 発明者: および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005230 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 寺本 章伸 (TER-AMOTO, Akinobu) [JP/JP].
(22) 国際出願日: 2004 年 4 月 13 日 (13.04.2004) (74) 代理人: 後藤 洋介, 外 (GOTO, Yosuke et al); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 4 番 10 号 第三ビル Tokyo (JP).
(25) 国際出願の言語: 日本語 (26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可給): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(30) 優先権データ: 特願2003-114616 2003 年 4 月 18 日 (18.04.2003) JP
(71) 出願人 および
(72) 発明者: 大見 忠弘 (OHMI, Tadahiro) [JP/JP]; 〒9800813 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋 2 丁目 1-17-301 Miyagi (JP).

(続葉有)

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND PROCESS FOR PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: 半導体装置及び半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A semiconductor device comprising a substrate of SiC provided with an insulating film through plasma treatment. Rare gas is incorporated in the insulating film. Preferably, at least one of krypton (Kr), argon (Ar) and xenon (Xe) is used as the rare gas. A combination of oxygen gas and krypton (Kr) is especially preferred.

(57) 要約: 本発明に係る半導体装置は、基板としてSiCを採用するとともに、プラズマ処理によって絶縁膜を形成している。このとき、絶縁膜中に希ガスを含有さ

(続葉有)

WO 2004/095562 A1